L10規則合金と3d遷移金属の磁性エピタキシャル二層膜の形成

Preparation of Epitaxial Magnetic Bi-layer Films Consisting of L10 Ordered Alloy and 3d Transition Metal

Ryoma Ochiai, Masahiro Nakamura, Youhei Noguchi, Mitsuru Ohtake,

Masaaki Futamoto, Fumiyoshi Kirino^{*}, and Nobuyuki Inaba^{**}

(Chuo Univ., ^{*}Tokyo Univ. Arts, ^{**}Yamagata Univ.)

はじめに 硬磁性と軟磁性材料からなる積層 膜は異方性ナノコンポジット磁石構造の基礎 検討や薄膜磁石としてマイクロモータや MEMS 応用に向けて研究されている. 硬磁性材 料として、専ら SmCo₅や Nd₂Fe₁₄B などの希土 類系合金材料が検討されているが、膜応用の場 合、 $L1_0$ 型構造を持つ FePd や FePt 合金なども 候補となる. しかしながら、 $L1_0$ 規則合金を用 いた形成報告例は殆ど無い¹³. 本研究では、 $L1_0$ 規則合金を用いた積層膜の可能性を検討する ことを目的に、結晶方位の異なる MgO 単結晶 基板上に硬磁性 $L1_0$ の FePd、FePt と高 M_s を持 っ Fe, Co からなる二層膜を形成し、構造と磁 気特性を調べた.

実験方法 膜形成には UHV-RF マグネトロ ンスパッタ装置を使用し,基板には(001), (011), (111)方位の MgO 単結晶を用いた.基 板上に FePd, FePt(20 nm)/Fe, Co(20 nm)の順で 積層した二層膜,および,積層順を逆にした 二層膜を 200 $^{\circ}$ の基板温度で形成した.そし て、すべての膜がエピタキシャル成長してい ることを RHEED 観察により確認した.製膜 後,A2 不規則構造の FePd および FePt 層を $L1_0$ 相に規則化させるために 600 $^{\circ}$ で熱処理 を施した.構造解析には RHEED, XRD, AFM, 磁気特性評価には VSM を用いた.

実験結果 Fig. 1(a)-(b)に FePd/Fe/MgO(001)と Fe/FePd/MgO(001)試料で測定した面外および 面内 XRD パターンを示す. 面外パターンでは FePd(001)超格子反射, FePd(002)基本反射, Fe(002)反射が観察されている. 一方, 面内 XRD パターンでは FePd(200)基本反射と Fe(110)反射は観察されているが, *L*1₀-FePd 結 晶からの超格子反射は認められない. 従って, いずれの試料とも, FePd 層は *c* 軸が面直に向



Fig. 1 (a-1)–(f-1) Out-of-plane and (a-2)–(f-2) in-plane XRD patterns of [(a), (c), (e)] FePd/Fe and [(b), (d), (f)] Fe/FePd films formed on MgO substrates of [(a), (b)] (001), [(c), (d)] (011), and [(e), (f)] (111) orientations.

いた *L*1₀(001)結晶から構成されていることが分かる. RHEED および XRD 解析から決定したエピタキシャル方位関係は FePd(001)[100]_{*L*1₀} || Fe(001)[110] || MgO(001)[100]である. Fig. 1(c)-(f)に MgO(011)および(111)基板上に形成した二層膜の XRD パターンを示す. MgO(011)基板上に形成した膜に対しては面外 FePd(022)と面内 FePd(200)基本反射, MgO(111)基板上に 形成した膜に対しては面外 FePd(111)と面内 FePd(220)+(220)基本反射が観察されているが, 明瞭な超格子反射は認められ ない. 基板結晶方位により規則相形成が異なる可能性も考えられる. 当日は磁気特性も含めて, FePt, Co を組み合わせ た結果についても報告する予定である.

<u>参考文献</u> 1) T. Teranishi, A. Wachi, M. Kanehara, T. Shoji, N. Sakuma, and M. Nakaya: *J. Am. Chem. Soc.*, **130**, 4210 (2008). 2) J. P. Liu, C. P. Luo, Y. Liu, and D. J. Sellmyer: *Appl. Phys. Lett.*, **72**, 483 (1998). 3) Y. K. Takahashi, T. O. Seki, K. Hono, T. Shima, and K. Takanashi: *J. Appl. Phys.*, **96**, 475 (2004).